MA 合成ナノ粉末を用いた熱間押出し 高配向性 SnSe 熱電変換材料の開発

鳥取大学 工学部機械物理系学科 准教授 音田 哲彦 (2019 年度 一般研究開発助成 AF-2019015-B2)

キーワード:熱電変換材料,熱間押出し,メカニカルアロイング

1. 研究の目的と背景

ー次エネルギーの多くは利用されておらず、未利用熱エ ネルギーとして廃棄されている。この未利用熱エネルギー の有効活用は、省エネルギーと CO_2 排出削減の重要な柱 であり、特に、電力としての回収(廃熱発電)には高いニー ズがある。そのため、熱エネルギーを電力に直接変換でき る熱電変換技術には大きな期待が寄せられている。熱電変 換材料の開発には、材料の性能を示す指針である熱電性能 指数 $ZT = \alpha^2 T/(\rho\kappa)$ (α :ゼーベック係数、 ρ :電気抵抗率、

 κ :熱伝導率、T:絶対温度)が1以上であることが求められている。これまでさまざまな熱電変換材料のZT値が報告されているがバルク材料の最大値は2014年にSnSe単結晶で報告されたZT=2.6である¹⁾。しかし単結晶では 製造コストや時間がかかるため、高い熱電性能を持つ多結晶のSnSeバルク材料が求められている。特にSnSeは特性異方性が強く、b軸、c軸方向で最大のZT値は2.6、2.3 だがa軸方向では0.8に下がる。したがって異方性を反映させたバルク試料が必要である。

我々は、組織の微細化によるフォノン熱伝導率低下と結晶 配向化の観点から、メカニカルアロイング(MA)による微細 粉末化合物の合成、この微細粉末を用いて放電プラズマ焼結 (SPS)あるいは熱間押出し加工により合金粉末を緻密化させ るプロセスを提案している^{2,3}。SPS 法では応力を印加しな がら試料の焼結を行うため応力軸に応じた結晶配向試料を 得ることが可能であり、いくつかの報告がある^{4,5)}。一方、 熱間押出し加工ではせん断応力により結晶配向化を実現し、 Bi2Te3 系熱電材料で高性能化の実績がある^{2,3,6,7)}。本研究で は、試料の配向度に着目し、焼結温度や押出し温度が SnSe 化合物の熱電性能と機械的性質に及ぼす影響を調べた。

2. 実験方法

Sn(99.9%、平均粒径 38µm)、Se(99.9%、平均粒径 10µm)粉末 を SnSe の化学量論組成になるように秤量し、Ar 雰囲気内にて MA によって合金化した。その後 SPS 装置で温度 350~600℃ の条件で焼結を行った。また、熱間押出しは MA 粉末を圧粉 後 Al シースに真空封入してビレット化させ、押出し温度 350 ~500℃の条件で熱間押出しを行った。得られた試料に対し て最適な熱電特性が得られる焼結温度と押出し温度を調べ るため、密度測定、X 線回折、組織観察、ゼーベック係数、 電気抵抗率、熱伝導率、ビッカース硬さの測定を行った。

3. 結果および考察

Sn と Se に対して MA を行ったところ、30 分で SnSe の 合成が観察され、XRD 測定からは4時間あまりでほぼ 100%単一相が得られた。結晶子径はMA4時間試料で10nm 以下になったがそれ以上行ってもわずかに小さくなるだけ であった。さまざまな MA 時間の試料について特性評価を 行ったところMAを12時間以上行った試料において特性の 再現性が得られたため、試料合成を12時間とした。

図1に押出し試料の押出し圧力—ストローク曲線を示 す。はじめに押出し圧力が徐々に増加し、ビレットが圧密 される。ビレットが更に圧縮されるとダイスに材料が充填 され、圧力が急激に上昇する。圧力の上昇が緩やかになっ ている辺りから押出しが始まる。押出し温度の上昇ととも に押出し圧力のレベルが低下する傾向が見られた。これは 押出し温度の上昇に伴いビレットの変形抵抗が減少した ためだと考えられる。



図2に500℃押出し試料の外観と断面を示す。Alシース の外観にはクラック等の目立った欠陥のない健全な試料 が得られた。その他の押出し温度試料も外観は同様で健全 な押出し試料が得られた。押出し試料の断面は外側をほぼ 一定厚さのAlシースに囲まれており、内部にSnSeが存在 している。試料直径は8mm程度であった。



図2 500℃押出し試料の外観と断面

図3に SPS 試料と押出し試料の相対密度の測定結果を 示す。MA した粉末を用いて SPS では 350~500℃、熱間 押出しでは 350~450℃の温度範囲で高い相対密度を有す る緻密な試料が得られた。さらに温度を上げると Se の昇 華により SPS 試料や押出し試料の密度が低下した。SPS 試料と比較して押出し試料の 500℃試料で密度が低下し たのは押出し時に高温状態の時間が SPS より長く、Se の 昇華が始まったためだと考えられる。そのため押出し温度 を 550℃まで上げるとさらに Se の昇華量が増えると判断 し今回は 500℃までの押出し成形を行った。



図4に SPS 試料と押出し試料の垂直断面と平行断面の XRD パターンを示す。SPS 試料では垂直断面の(400)ピー クが平行断面より強いことがわかった。これはSPS によっ て加圧方向と平行に a 軸が配向していることによるもの と考えられる。また、押出し試料では平行断面の(400)ピー クが平行断面より強く、垂直断面の(020)ピークが平行断 面より強い。よって押出し方向と垂直に a 軸が、平行に b 軸が配向していることになり、成形した試料に結晶異方性 を付与できた。

各断面の XRD 測定結果から Lotgering 法⁸により得られ た(h00)、(0k0)、(001)の配向因子をそれぞれ a 軸、b 軸、c 軸の配向因子として定量的に評価した。図5に SPS 試料 の平行断面および押出し試料の垂直断面から得られた配 向因子を示す。図4の XRD パターンからは大きな結晶配 向性が付与できたように見られるが、定量解析の結果、 SPS 試料の平行断面および押出し試料の垂直断面のb軸の 配向因子は0.1以下であり、c軸はさらに小さい。SPS 試 料では焼結温度の上昇に伴いb軸の配向は低下しc軸の配 向はほとんど変化していない。さらに、600℃焼結体では 平行断面でも a 軸の配向因子が正となっており結晶異方 性が大きく低下していることがわかる。それに対して押出 し試料ではわずかであるが押出し温度とともにb軸、c軸 ともに上昇しており結晶配向性は向上している。押出しに よるせん断変形が温度上昇により変形しやすくなったこ とを反映していると思われる。これらの結果から、500℃ を越える高温、特に600℃では材料が軟化し、圧力の効果 が小さくなったと考えられる。一方 500℃までの温度では

試料の軟化度が小さいため、SPS、押出しともに結晶配向 値は上昇したと考えられる。SPS と押出しを比較すると、 SPS のような圧縮圧力よりも押出しのようなせん断応力 のほうが SnSe の結晶異方性を得るのには有効であったと 考えられる。また、これらの面に垂直な断面である SPS 試料の垂直断面および押出し試料の平行断面から得られ た a 軸の配向因子は 0.4 近い値を示した。したがって、今 回の実験条件において、SPS、熱間押出しは a 軸の結晶配 向性試料を作製するのには有効であるが、b、c 軸の配向 性試料を作製するには不十分であったと考えられる。







図6に SPS 試料の反射電子像を示す。全ての組織は主 に、黒色、灰色、白色の3つのコントラストから構成され ている。黒色領域は空隙及び空孔に対応し、白色領域は母 相に対応する。焼結温度が上昇すると結晶粒が大きくなり、 600℃焼結試料では灰色の相が明確に観察され、分析の結 果、Se-rich 相であることが確認された。



図 6 SPS 試料の反射電子像 (a) SPS450℃ (b) SPS500℃ (c) SPS550℃ (d) SPS600℃

図7に押出し試料の平行断面(押出し方向は上下方向) の反射電子像を示す。SPS 試料と比較して緻密な組織であ ることがわかる。押出し温度の上昇とともに黒色の領域が 大きくなっており、押出し温度 450℃、500℃の試料では 押出し方向である上下方向に平行に組織が伸張している ことが観察された。



図7 押出し試料の反射電子像 (a) HE350℃ (b) HE400℃ (c) HE450℃ (d) HE500℃

図8に SPS 試料および押出し試料の結晶粒径を示す。 SPS 試料では焼結温度とともに粒成長が見られるが、 500℃以上では急激に粒径が増大した。一方押出し試料で は 500℃までの範囲では粒成長は見らなかった。





図9に SPS 試料の垂直断面および押出し試料の平行断 面のゼーベック係数の温度依存性を示す。ゼーベック係数 は SPS 試料、押出し試料ともに室温から約 300℃まで緩や かに上昇し、その後下降した。また、SPS 焼結温度および 押出し温度の違いは、低温で作製したものほど高い値を示 したが、高温ではその差異は減少し、最高測定温度の 500℃ではどの材料もほぼ同じ値に収束した。



図10に SPS 試料の垂直断面および押出し試料の平行 断面の電気抵抗率の温度依存性を示す。どちらの試料も室 温の抵抗率は高く、150℃くらいまで減少しその後 300℃ くらいまで上昇したのち、低下した。SPS 試料では、焼結 温度による違いはほとんど見られなかった。押出し試料で は押出し温度が高いものほど抵抗が高い傾向がみられた が、ゼーベック係数同様に 500℃ではその違いは見られな くなった。組織観察から粒成長が見られた SPS 試料では 違いが見られず、粒径差がほとんどない押出し試料に違い が見られた。

図11に SPS 試料および押出し試料の熱伝導率の温度依存性を示す。熱伝導率は測定温度の上昇に伴って低下したが高温ではその低下率が低下した。焼結温度や押出し温度による大きな相違はほとんど見られなかったが、SPS 試料は熱間押出し試料よりも低い値をとった。また、SPS の450℃と500℃焼結試料は高温でも低下率の変化が小さかった。



(a) SPS 試料 (b) 押出し試料

図12にSPS 試料および押出し試料のZTの温度依存性 を示す。SnSe は中温度域での熱電性能が高いため測定温 度 400℃以上で ZT が大きく上昇している。ゼーベック係 数、電気抵抗率が低温では各試料で差が見られたが高温に なるにしたがって収束しており、特に500℃ではその違い がほとんどなくなっていた。そのため、ZT に見られる差 異は熱伝導率を反映していると考えられる。SPS 試料では 450℃、500℃焼結試料の熱伝導率が測定温度 350℃以上で も低下し続けたことを反映して、ZT が 350℃以上で上昇 している。一方押出し試料では熱伝導率が350℃押出し試 料だけがわずかに小さかったため、ZT もほかの試料より もわずかに高い値を示した。SPS 試料では焼結温度が上昇 するとZT が低下したのは結晶粒成長と密度の低下が原因 だと考えられる。押出し試料は押出し温度にかかわらず結 晶粒径の大きさにあまり変化が見られないため ZT に及ぼ す押出し温度の影響が小さいことが分かる。SPS 試料では 焼結温度 450℃試料において最大で ZT=0.81 が得られ、押 出し試料では押出し温度 350℃試料において最大で

ZT=0.62 が得られた。SPS 試料が押出し試料よりも高い ZT の値を示したのは、熱伝導率が低下したことが主な原因だ と考えられる。測定温度を 550℃以上にすることでさらに ZT の値が上昇する可能性はある。実際、SnSe 単結晶の 500℃における ZT 値は a 軸、b 軸、c 軸でそれぞれ、0.45、 1.5、1.2 であり、最大の ZT 値は 650℃で観察されたもの である。しかし、500℃を越える高温では SnSe 結晶は熱分 解により Se の昇華が起こることが報告されており ⁹、本 研究では 500℃までしか熱電特性の測定は行っていない。



図13 平行断面および垂直断面のビッカース硬さ(a) SPS 試料 (b) 押出し試料

図13に SPS 試料の焼結温度および押出し試料の押出 し温度に対するビッカース硬さ変化を平行断面と垂直断 面について測定した結果を示す。どちらの試料も焼結温度、 押出し温度の上昇にともない硬さは減少している。特に SPS 試料ではその変化が顕著である。これは結晶粒の成長 と密度低下の影響であると考えられる。押出し試料では押 出し温度の上昇にともなう硬さの低下は小さい。また、 SPS 試料と押出し試料ともに平行断面と垂直断面で硬さ の違いは小さく、結晶異方性は示されたが、硬さの異方性 は小さいと考えられる。

4.結論

- Sn と Se をメカニカルアロイング(MA)することで、
 約 30 分で合成が始まり、4 時間でほぼ 100%の SnSe が合成できる。
- (2) SPS では 350~500℃の温度範囲で、熱間押出し加工 では 350~450℃の温度範囲で緻密な試料が得られた。
- (3) 結晶の配向に異方性があり、SPS では加圧方向と平 行に a 軸が配向し、熱間押出しでは押出し方向と平 行に b 軸、垂直に a 軸が配向した。
- (4) SPS 試料は焼結温度 450、500℃試料では同様の組織 を示し、550℃試料では組織が粗くなり、600℃試料 では大きな結晶粒が観察される。押出し試料は 500℃ 試料で大きな空隙が観察される。

- (5) SPS 試料の ZT は、測定温度 400℃以上で大きく上昇し、 焼結温度 450℃試料において最大で ZT=0.81 が得られた。また、熱間押出し試料の ZT も SPS 試料と同様に、 測定温度 400℃以上で大きく上昇し、押出し温度 350℃ 試料において最大で ZT=0.62 が得られた。
- (6) 焼結温度と押出し温度が上昇すると硬さが減少した。 どちらの作製方法とも硬さによる異方性は小さいと考 えられる。

謝 辞

本研究は公益財団法人天田財団による一般研究開発助 成 AF-2019015-B2 の支援を受けて遂行されたものである。 ここに感謝の意を表する。

参考文献

- 1) L.-D. Zhao et al, Nature, 508 (2014), 373-377.
- 2) Z. Wang et al, Scripta Mat., 136 (2017) 111-114.
- 3) Z. Wang, et al., Scripta Mat., 146 (2018) 119-122.
- 4) Y. Li, et al., Energies, 8 (2015) 6275-6285.
- 5) H. Liu, et al., J. Ele. Mat., 46 (2017) 26292633.
- 6) Z. Wang, et al., J. Mat. Sci., 53 (2018) 9117-30.
- 7) Z. Wang, et al., Adv. Ele. Mat., 5 (2019) 1900079.
- 8) F.K. Lotgering, J. Inorg. Nucl. Chem., 9(1959) 113-123.
- 9) Y. Li, et al., J. Alloy Compd, 669 (2016) 224-231.